

Si-NPN-Fototransistor Typ FT-30

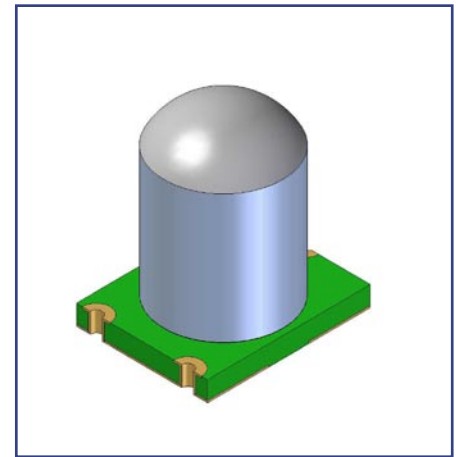


MERKMALE

- ▶ Integrierte, abgestimmte Hochleistungsoptik
- ▶ Keine zusätzlichen Linsen erforderlich
- ▶ Extrem kleine Empfangs- und Schielwinkel
- ▶ 3mm-Bauform, Metallgehäuse

ANWENDUNG

- ▶ Für optische Sensoren

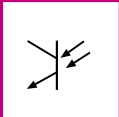


▶ **ELEKTRISCHE DATEN**

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Dunkelstrom I_{ceo}	$V_{ce}=20V$; $H=0mW/cm^2$	< 100	nA
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung V_{cesat}	$I_c=2mA$; $I_b=100\mu A$	<0,3	V
Kollektor-Emitter-Durchbruch (U_{ceo})	$I_c=100\mu A$; $I_b=0$	>60	V
Spektrale Fotoempfindlichkeit	650nm 875nm 940nm	95 148 95	A/W
Emitter-Kollektor- Durchbruch (V_{eco})	$I_e=100\mu A$; $I_b=0$	>5	V
Versorgungsspannung		+0....+30	V

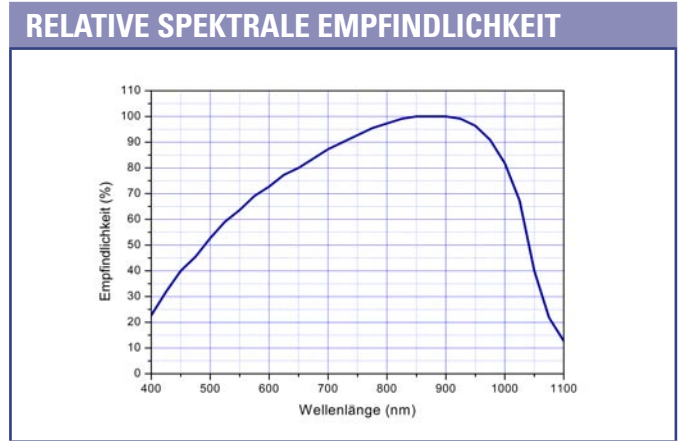
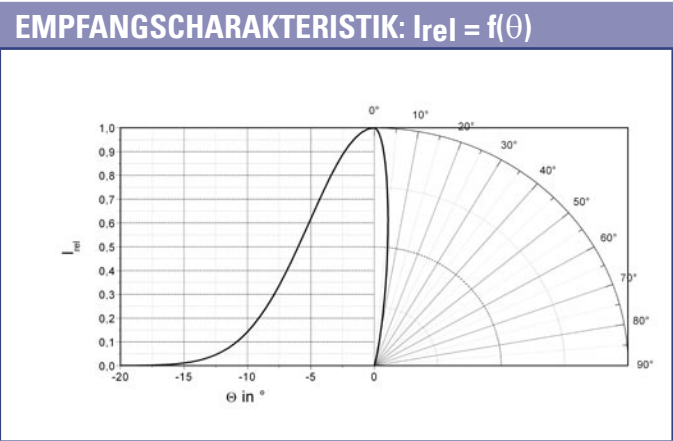
▶ **TYPISCHE WERTE**

Parameter	Testbedingung	typ. Werte	Einheit
Nutzbarer Wellenlängenbereich		400-1000	nm
Ansprechzeit t_r t_f	10%-90% ; $I_c=1mA$, $V_{ce}=5V$; $R_l=1k\Omega$	15 15	μsec μsec
Bestrahlungsempfindliche Fläche (A)		0,11	mm ²
Empfangswinkel (θ)		6	Grad

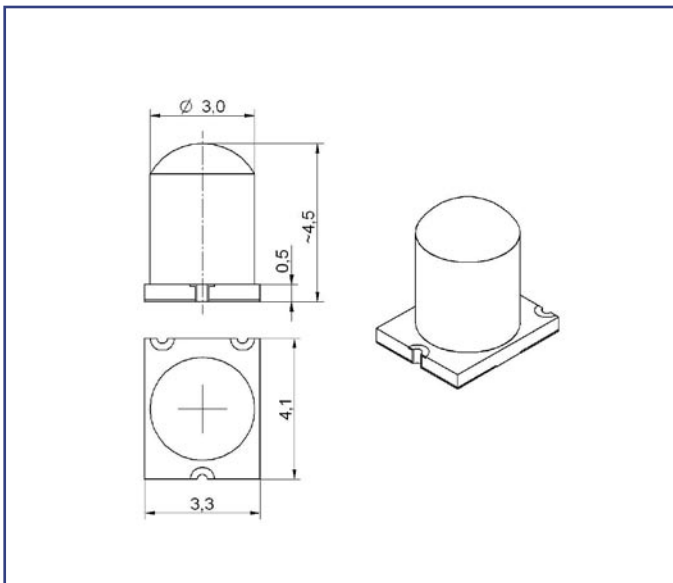


Si-NPN-Fototransistor Typ FT-30

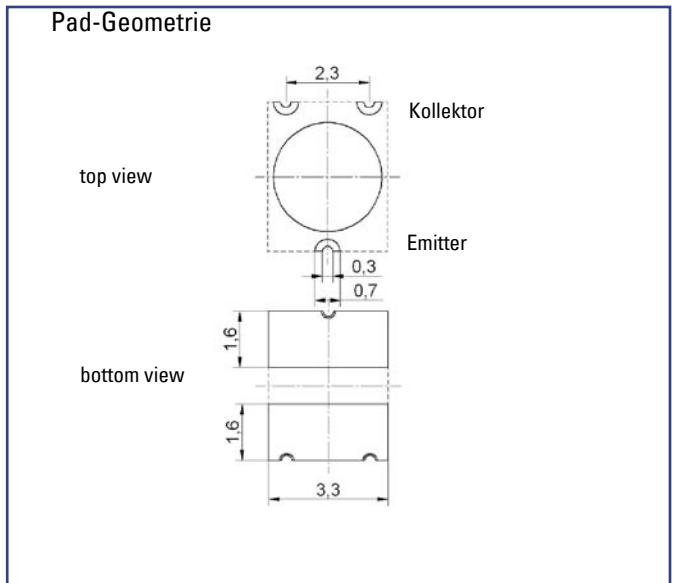
► DIAGRAMME



► ABMESSUNGEN GEHÄUSE



► ANSCHLÜSSE



BESTELLBEZEICHNUNG

OE-FT-30-VA1-SL21-2-0115